

CD・DVD プレーヤ用 システムモータドライバシリーズ

# カーAV 用

# 5ch システムモータドライバ

**BD8205EFV-M**

## 概要

BD8205EFV-M は DC モータ(スピンドルモータ、送りモータ(Sled)、ローディングモータ)、及びアクチュエータ用コイル(トラッキング、フォーカス) 駆動用に開発された 5ch システムモータドライバです。CD・DVD ドライブを構成するモータとコイルを駆動することが可能です。

## 特長

- 5ch BTL ドライバ
- CH1,2,3(DC モータ)用 POWVCC1 と CH4,5(アクチュエータ)用 POWVCC2 が独立しており、効率のよいドライブが可能
- 保護機能内蔵 (TSD, UVLO, BIAS 降下ミュート)
- AEC-Q100 対応

## 用途

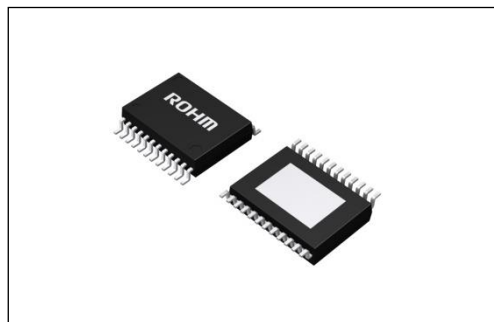
カーオーディオ

## 重要特性

- ドライバ電源電圧範囲  $V_{POWVCC1}$  6V~10V  
 $V_{POWVCC2}$  4.3V~ $V_{POWVCC1}$
- 動作温度範囲 -40°C~+85°C
- 出力オフセット (CH1,2,3)  $\pm 100\text{mV}(\text{Max})$
- 出力オフセット (CH4,5)  $\pm 50\text{mV}(\text{Max})$
- 最大出力振幅 (CH1,2,3,4,5) 6V(Typ)

## パッケージ

	W(Typ)	D(Typ)	H(Max)
HTSSOP-B24	7.80mm	7.60mm	1.00mm



HTSSOP-B24

## 基本アプリケーション回路

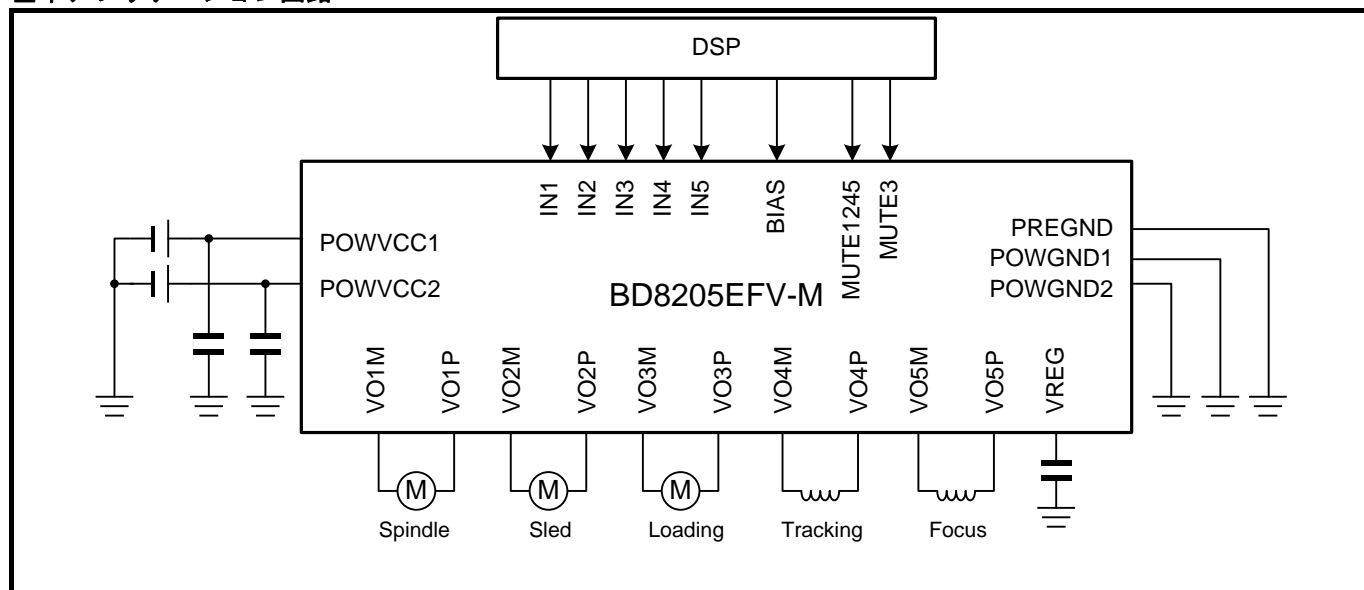


Figure 1. アプリケーション回路

子配置図

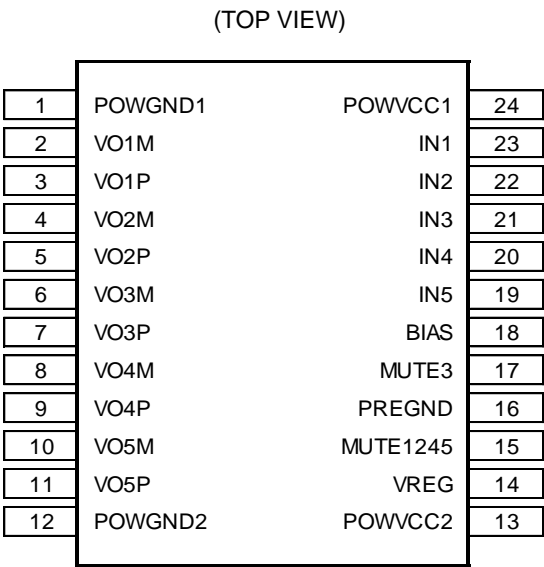


Figure 2. 端子配置図

端子説明

No.	端子名	機能
1	POWVCC1	パワー部 GND1
2	VO1M	CH1 ドライバ 負出力
3	VO1P	CH1 ドライバ 正出力
4	VO2M	CH2 ドライバ 負出力
5	VO2P	CH2 ドライバ 正出力
6	VO3M	CH3 ドライバ 負出力
7	VO3P	CH3 ドライバ 正出力
8	VO4M	CH4 ドライバ 負出力
9	VO4P	CH4 ドライバ 正出力
10	VO5M	CH5 ドライバ 負出力
11	VO5P	CH5 ドライバ 正出力
12	POWVCC2	パワー部 GND2
13	POWVCC2	パワー部電源 2
14	VREG	内部回路用電源出力
15	MUTE1245	CH1,2,4,5 ミュート入力端子
16	PREGND	プリ部 GND
17	MUTE3	CH3 ミュート入力端子
18	BIAS	基準電圧入力端子
19	IN5	CH5 入力端子
20	IN4	CH4 入力端子
21	IN3	CH3 入力端子
22	IN2	CH2 入力端子
23	IN1	CH1 入力端子
24	POWVCC1	パワー・プリ部電源 1

ブロック図

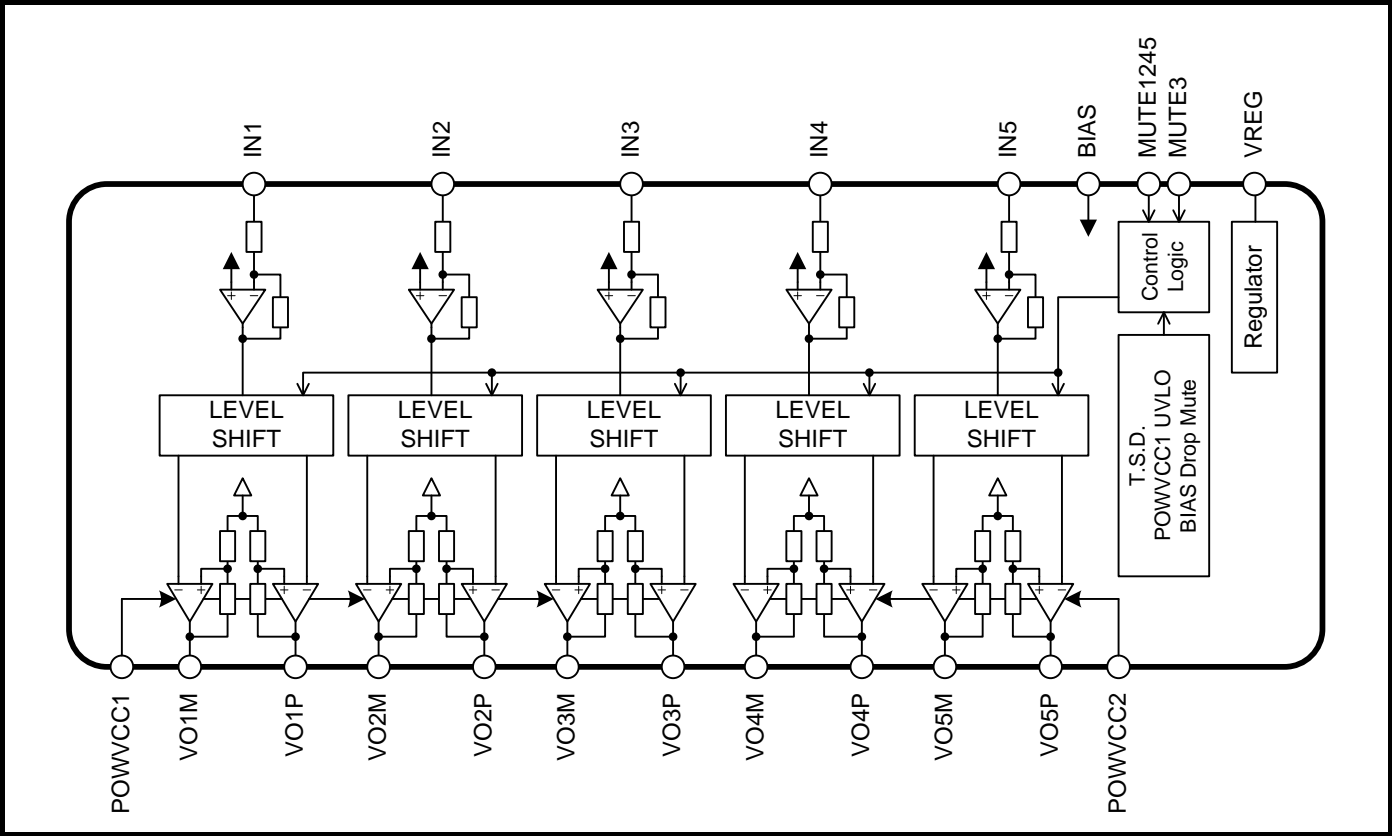


Figure 3. ブロック図

絶対最大定格(Ta=25°C)

項目	記号	定格	単位
電源電圧 1	V <sub>POWVCC1</sub>	12	V
電源電圧 2	V <sub>POWVCC2</sub>	V <sub>POWVCC1</sub>	V
入力端子電圧 1	V <sub>IN1</sub> (Note 1)	12	V
入力端子電圧 2	V <sub>IN2</sub> (Note 2)	7	V
許容損失	Pd	1.10 (Note 3)	W
		3.99 (Note 4)	
動作温度範囲	Topr	-40 ~ +85	°C
保存温度範囲	Tstg	-55 ~ +150	°C
接合部温度	Tjmax	+150	°C

(Note 1) MUTE 1245, MUTE3 端子を示す  
(Note 2) IN1, IN2, IN3, IN4, IN5, BIAS の各端子を示す  
(Note 3) 70mm×70mm、厚さ 1.6mm、1 層基板 (裏面銅箔 0mm×0mm)  
Ta=25°C 以上で使用する場合は、1°C につき 8.8mW を減じる  
(Note 4) 70mm×70mm、厚さ 1.6mm、4 層実装時 (裏面銅箔 70mm×70mm)  
Ta=25°C 以上で使用する場合は、1°C につき 32.0mW を減じる  
**注意：**印加電圧及び動作温度範囲などの絶対最大定格を超えた場合は、劣化または破壊に至る可能性があります。また、ショートモードもしくはオープンモードなど、破壊状態を想定できません。絶対最大定格を超えるような特殊モードが想定される場合、ヒューズなど物理的な安全対策を施して頂けるようご検討をお願いします。

推奨動作条件 (Ta = -40°C ~ +85°C)

項目	記号	最小	標準	最大	単位
プリ部電源, DC モータ系パワー電源 (Note 1)	V <sub>POWVCC1</sub>	6	8	10	V
アクチュエータ系パワー電源 (Note 1)	V <sub>POWVCC2</sub>	4.3	8	V <sub>POWVCC1</sub>	V

(Note 1) 電源電圧は、許容損失を考慮の上決定してください

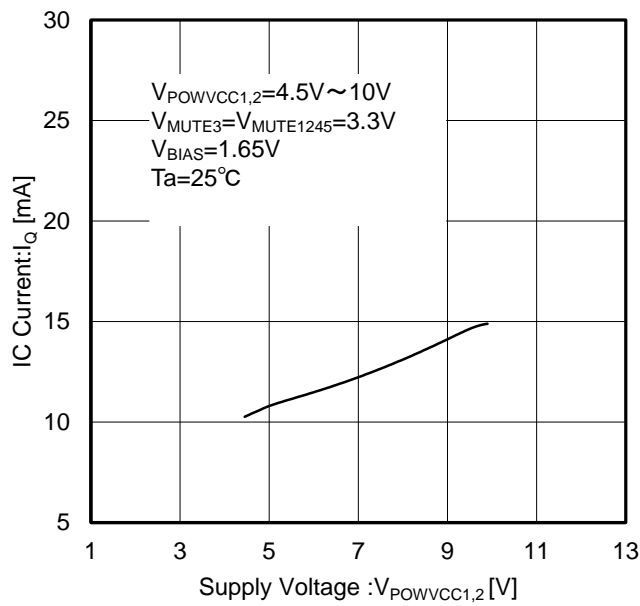
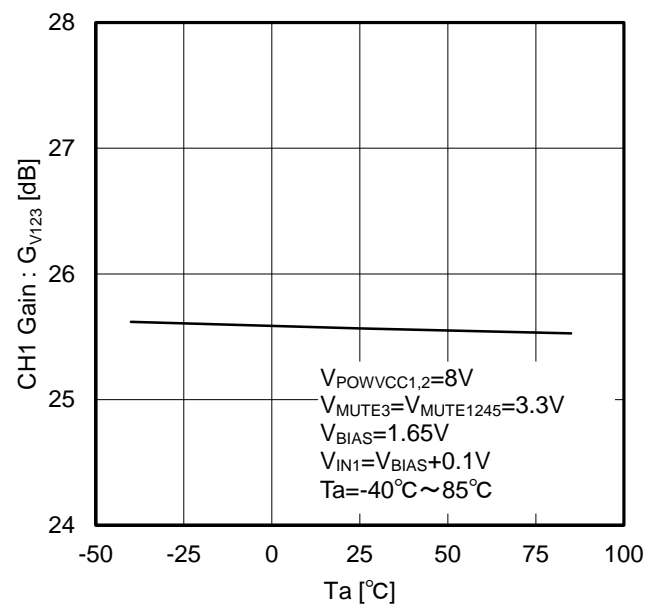
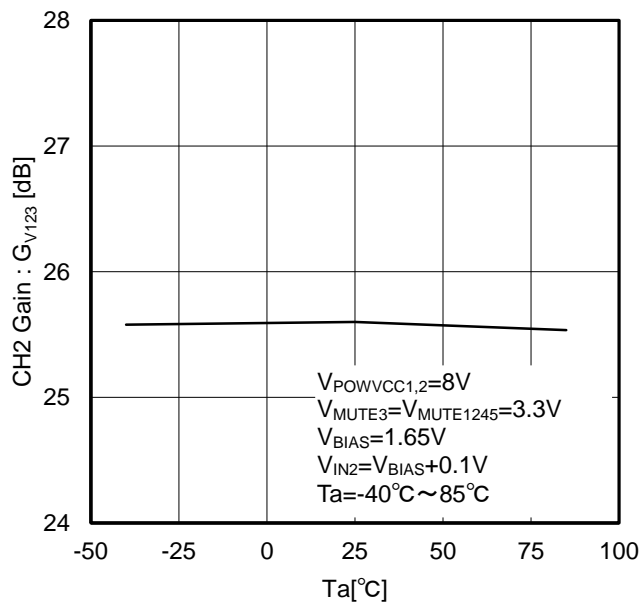
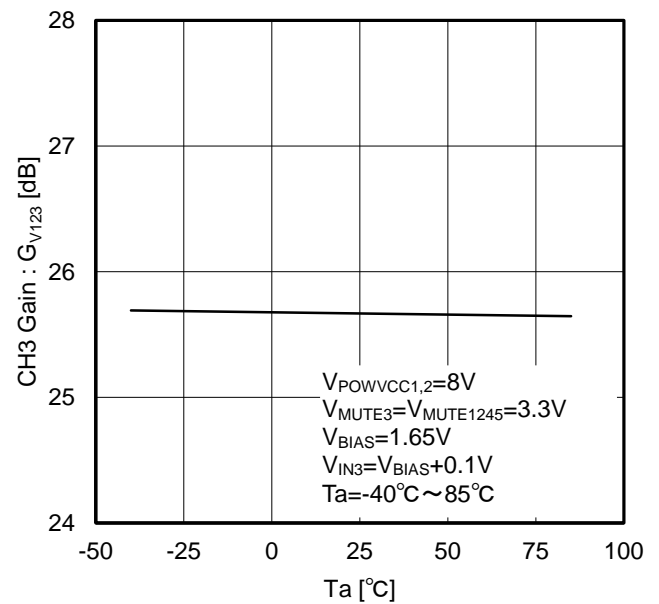
電氣的特性 (特に指定のない限り Ta=25°C,  $V_{POWVCC1}=V_{POWVCC2}=8V$ ,  $V_{BIAS}=1.65V$ ,  $R_L=8\Omega$ )

項目	記号	規格値			単位	条件
		最小	標準	最大		
< 回路電流 >						
無信号時消費電流	I <sub>Q</sub>	—	13	30	mA	無負荷時、V <sub>MUTE1245,3</sub> =H
< ドライバ >						
出力オフセット電圧 (CH1,2,3)	V <sub>OOF123</sub>	-100	0	100	mV	
出力オフセット電圧 (CH4,5)	V <sub>OOF45</sub>	-50	0	50	mV	
最大出力振幅 (CH1,2,3,4,5)	V <sub>OM</sub>	5.3	6.0	—	V	RON(上下和)=2.5Ω(Typ)相当
閉回路電圧利得 (CH1,2,3)	G <sub>V123</sub>	24.0	25.7	27.4	dB	
閉回路電圧利得 (CH4,5)	G <sub>V45</sub>	15.5	17.5	19.5	dB	
入力インピーダンス (CH1,2,3)	R <sub>IN123</sub>	13	20	27	kΩ	
入力インピーダンス (CH4,5)	R <sub>IN45</sub>	30	47	64	kΩ	
< その他 >						
MUTE1245,3 端子ローレベル電圧	V <sub>ML</sub>	—	—	0.5	V	
MUTE1245,3 端子ハイレベル電圧	V <sub>MH</sub>	2.0	—	—	V	
MUTE1245,3 端子流入電流	I <sub>MUTE</sub>	32	52	74	μA	V <sub>MUTE1245,3</sub> =3.3V
BIAS 降下ミュート	V <sub>BIAS</sub>	0.5	0.7	0.9	V	
BIAS 端子流入電流	I <sub>BIAS</sub>	32	52	74	μA	V <sub>BIAS</sub> =1.65V
POWVCC1 UVLO 検出電圧	V <sub>UVLOD</sub>	3.4	3.8	4.2	V	
POWVCC1 UVLO 解除電圧	V <sub>UVLOR</sub>	3.6	4.0	4.4	V	
VREG 端子電圧	V <sub>VREG</sub>	—	5.0	—	V	C <sub>VREG</sub> =0.1μF

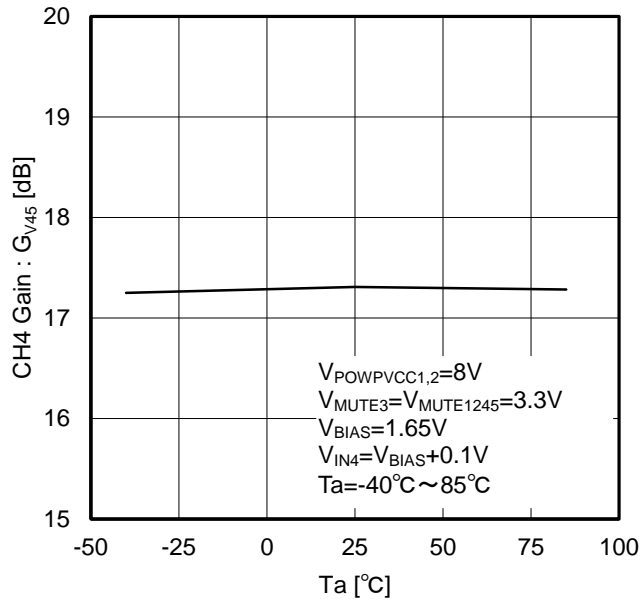
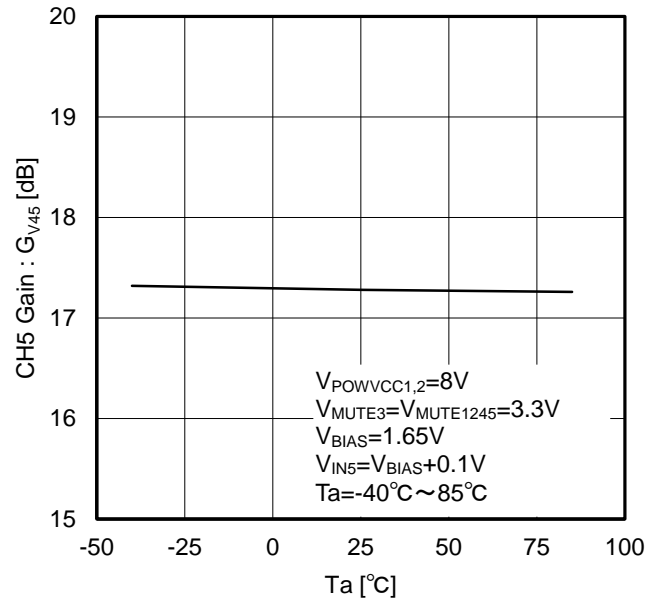
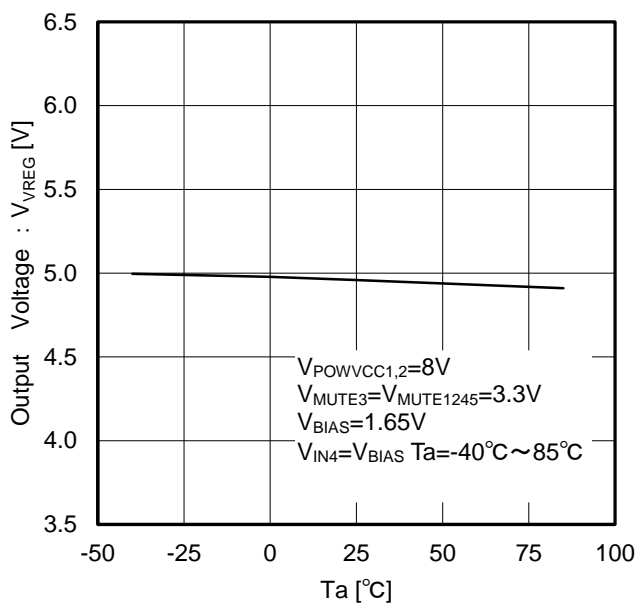
電氣的特性 (特に指定のない限り Ta=-40°C~85°C, V<sub>POWVCC1</sub>=V<sub>POWVCC2</sub>=8V, V<sub>BIAS</sub>=1.65V, R<sub>L</sub>=8Ω)

項目	記号	規格値			単位	条件
		最小	標準	最大		
< 回路電流 >						
無信号時消費電流	I <sub>Q</sub>	—	13	33	mA	無負荷時、V <sub>MUTE1245,3</sub> =H
< ドライバ >						
出力オフセット電圧 (CH1,2,3)	V <sub>OOF123</sub>	-100	0	100	mV	
出力オフセット電圧 (CH4,5)	V <sub>OOF45</sub>	-50	0	50	mV	
最大出力振幅 (CH1,2,3,4,5)	V <sub>OM</sub>	4.8	6.0	—	V	RON(上下和)=2.5Ω(Typ)相当
閉回路電圧利得 (CH1,2,3)	G <sub>V123</sub>	24.0	25.7	27.4	dB	
閉回路電圧利得 (CH4,5)	G <sub>V45</sub>	15.5	17.5	19.5	dB	
入力インピーダンス (CH1,2,3)	R <sub>IN123</sub>	10	20	28	kΩ	
入力インピーダンス (CH4,5)	R <sub>IN45</sub>	28	47	66	kΩ	
< その他 >						
MUTE1245,3 端子ローレベル電圧	V <sub>ML</sub>	—	—	0.4	V	
MUTE1245,3 端子ハイレベル電圧	V <sub>MH</sub>	2.0	—	—	V	
MUTE1245,3 端子流入電流	I <sub>MUTE</sub>	22	52	108	μA	V <sub>MUTE1245,3</sub> =3.3V
BIAS 降下ミュート	V <sub>BIAS</sub>	0.3	0.7	1.1	V	
BIAS 端子流入電流	I <sub>BIAS</sub>	22	52	108	μA	V <sub>BIAS</sub> =1.65V
POWVCC1 UVLO 検出電圧	V <sub>UVLOD</sub>	3.4	3.8	4.2	V	
POWVCC1 UVLO 解除電圧	V <sub>UVLOR</sub>	3.6	4.0	4.4	V	
VREG 端子電圧	V <sub>VREG</sub>	—	5.0	—	V	C <sub>VREG</sub> =0.1μF

## 特性データ (参考データ)

Figure 4. 無信号時消費電流:  $I_Q$ Figure 5. CH1 閉回路電圧利得:  $G_{V123}$ Figure 6. CH2 閉回路電圧利得:  $G_{V123}$ Figure 7. CH3 閉回路電圧利得:  $G_{V123}$

## 特性データ (参考データ)

Figure 8. CH4 閉回路電圧利得:  $G_{V45}$ Figure 9. CH5 閉回路電圧利得:  $G_{V45}$ Figure 10. VREG 基準電圧:  $V_{VREG}$

## 機能解説

## 1. ドライバ制御端子 MUTE1245(Pin15), MUTE3(Pin17), BIAS(Pin18)

MUTE1245 端子及び MUTE3 端子に High レベル(2V 以上)または、Low レベル(0.8V 以下)を入力することで、各ドライバ出力の ON/OFF の切り替えができます。BIAS 端子による BIAS 降下ミュート機能と合わせ、モード切り替えの内容は以下の通りです。

## ▼ドライバ論理 (通常使用状態)

状態 No.	入力			出力 <sup>(Note 1) (Note 2)</sup>				
	MUTE1245	MUTE3	BIAS	CH1 (SP)	CH2 (SL)	CH3 (LD)	CH4 (FC)	CH5 (TK)
1	H	H	H	Active	Active	Active	Active	Active
2	H	L	H	Active	Active	MUTE	Active	Active
3	L	H	H	MUTE	MUTE	Active	MUTE	MUTE
4	L	L	H	MUTE	MUTE	MUTE	MUTE	MUTE
5	H	H	L	MUTE	MUTE	MUTE	MUTE	MUTE
6	H	L	L	MUTE	MUTE	MUTE	MUTE	MUTE
7	L	H	L	MUTE	MUTE	MUTE	MUTE	MUTE
8	L	L	L	Hi-Z	Hi-Z	Hi-Z	Hi-Z	Hi-Z

## ▼ドライバ論理 (UVLO, TSD 動作時)

状態 No.	入力			出力 <sup>(Note 1) (Note 2)</sup>				
	MUTE1245	MUTE3	BIAS	CH1 (SP)	CH2 (SL)	CH3 (LD)	CH4 (FC)	CH5 (TK)
9	L	L	L	Hi-Z	Hi-Z	Hi-Z	Hi-Z	Hi-Z
10	その他の状態			MUTE	MUTE	MUTE	MUTE	MUTE

(Note 1) MUTE：正負出力が共に電源/2(=V<sub>REF</sub>)の電圧にプルアップされた状態

(Note 2) Hi-Z：正負出力が共に Hi-Z

## 2. BIAS 降下ミュート機能

BIAS 電圧が 0.7V (Typ)以下になると、すべてのチャンネルの出力がオフします。  
出力状態の詳細は上記表を参照してください。通常使用状態では 1.2V 以上にしてください。

## 3. POWVCC1 降下ミュート(UVLO)機能

POWVCC1 端子電圧が 3.8V (Typ)以下になると、すべてのチャンネルの出力がオフします。  
出力状態の詳細は上記表を参照してください。再び 4.0V(Typ)まで上昇すると復帰します。

## 4. サーマルシャットダウン

IC を熱破壊から防ぐ為、サーマルシャットダウン(温度保護回路)を内蔵しています。  
必ずパッケージの許容損失内でご使用いただきたいのですが、万が一許容損失を超えた状態で放置されますと、ジャンクション温度が上昇し 175°C(Typ)でサーマルシャットダウンが動作します(すべてのチャンネル出力をオフします)。  
出力状態の詳細は上記表を参照してください。その後、ジャンクション温度が 150°C(Typ)まで低下すると、再び動作を開始します。ただし、サーマルシャットダウンが動作している状態でも、外部からさらに熱が加え続けられると熱暴走し、破壊に至る可能性があります。

## 5. 基準電圧 (VREG, Pin14)

POWVCC1 電圧から 5V (Typ) を生成します。この電圧(V<sub>VREG</sub>)は内部回路の電源です。VREG 端子には位相補償用容量として C<sub>VREG</sub>=0.1μF の接続を推奨致します。また、そのばらつきは 0.068μF~0.22μF の範囲になるようにしてください。C<sub>VREG</sub> が接続されていない場合、回路動作が著しく不安定になります。また、他の部品用電源としての設計はしておりませんので、コンデンサのみを接続してご使用ください。

## 6. 閉回路電圧利得算出方法

## i) スピンドル・スレッド・ローディング

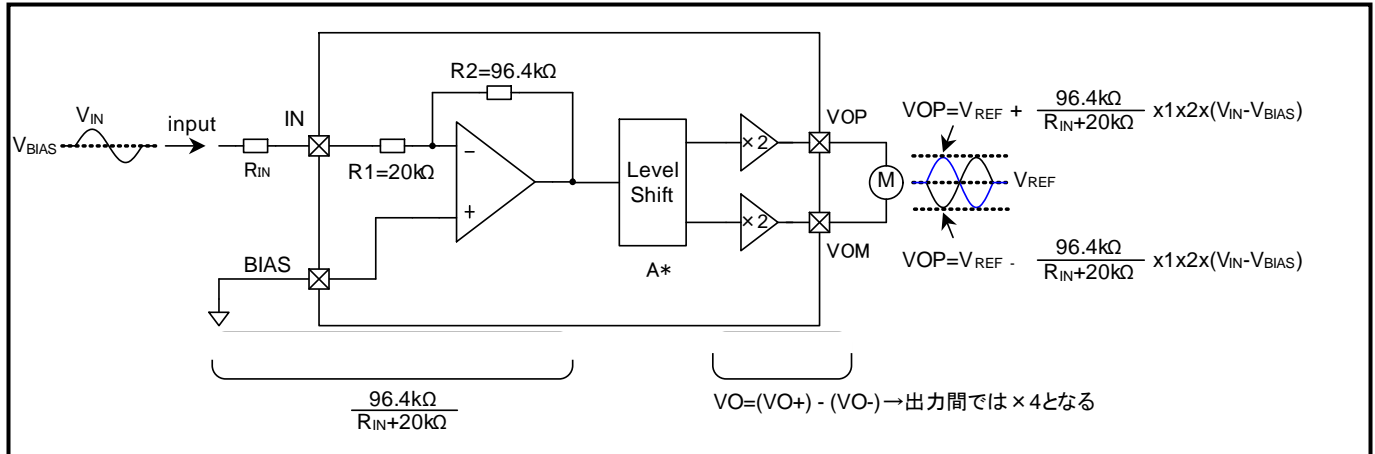


Figure 11. スピンドル・スレッド・ローディング閉回路電圧利得算出図

$$Gain = \frac{96.4k\Omega}{R_{IN} + 20k\Omega} \times 1 \times 2 \times 2 \text{ [dB]}$$

$R_{IN}$  を使用しない場合は次式となります。

$$Gain = \frac{96.4k\Omega}{20k\Omega} \times 1 \times 2 \times 2 = 25.7 \text{ [dB]}$$

※各パラメータのバラツキについて

$R1 = 20k\Omega \pm 18\%$

$R2 = 96.4k\Omega \pm 18\%$

$R2/R1 = 4.82 \pm 2.5\%$

$* A = 1 \pm 18\%$

を考慮してください。

## ii) フォーカス・トラッキング

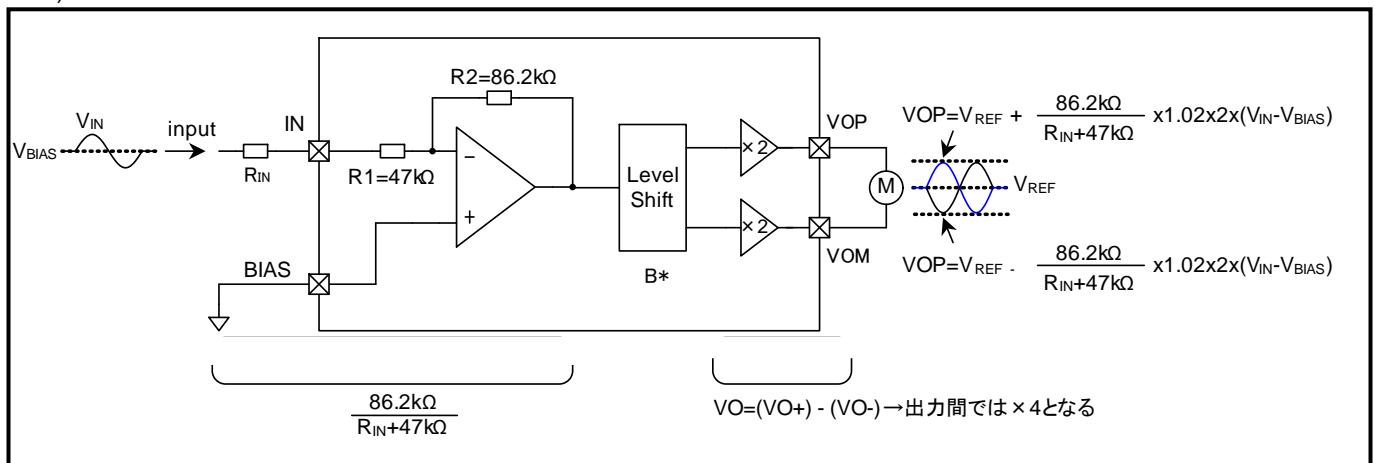


Figure 12. フォーカス・トラッキング閉回路電圧利得算出図

$$Gain = \frac{86.2k\Omega}{R_{IN} + 47k\Omega} \times 1.02 \times 2 \times 2 \text{ [dB]}$$

$R_{IN}$  を使用しない場合は次式となります。

$$Gain = \frac{86.2k\Omega}{47k\Omega} \times 1.02 \times 2 \times 2 = 17.5 \text{ [dB]}$$

※各パラメータのバラツキについて

$R1 = 47k\Omega \pm 18\%$

$R2 = 86.2k\Omega \pm 18\%$

$R2/R1 = 4.82 \pm 2.5\%$

$* B = 1.02 \pm 26\%$

を考慮してください。

## タイミングチャート

## 1. 信号の種類

- ・外部電源 : POWVCC1, POWVCC2
- ・内部電源 : VREG
- ・基準電圧入力 : BIAS
- ・ドライバ入力 : IN1, IN2, IN3, IN4, IN5
- ・ミュート制御入力 : MUTE1245, MUTE3
- ・ドライバ出力 : VO1P, VO1M, VO2P, VO2M, VO3P, VO3M, VO4P, VO4M, VO5P, VO5M,

## 2. 起動シーケンスについて

- (1)外部電源を投入します。このとき、電源電圧が5Vに到達するまでの立ち上がりスループレートは $0.045\text{V}/\mu\text{s}$ 以下を推奨いたします。急峻に電源電圧を立ち上げますと、VREG電圧のオーバーシュートが発生し内部素子破壊に至る可能性があります。また、電源電圧は $\text{POWVCC1} \geq \text{POWVCC2}$ の関係を守ってください。
- (2)基準電圧入力(BIAS)を投入します。なお、BIASはシーケンスフリーですので、電源投入前の入力も可能です。
- (3)POWVCC1電源電圧が4.0V(UVLO解除電圧)に到達後、ミュート制御入力を投入します。
- (4)ミュート制御入力後、各ドライバ入力に任意の電圧を入力します。

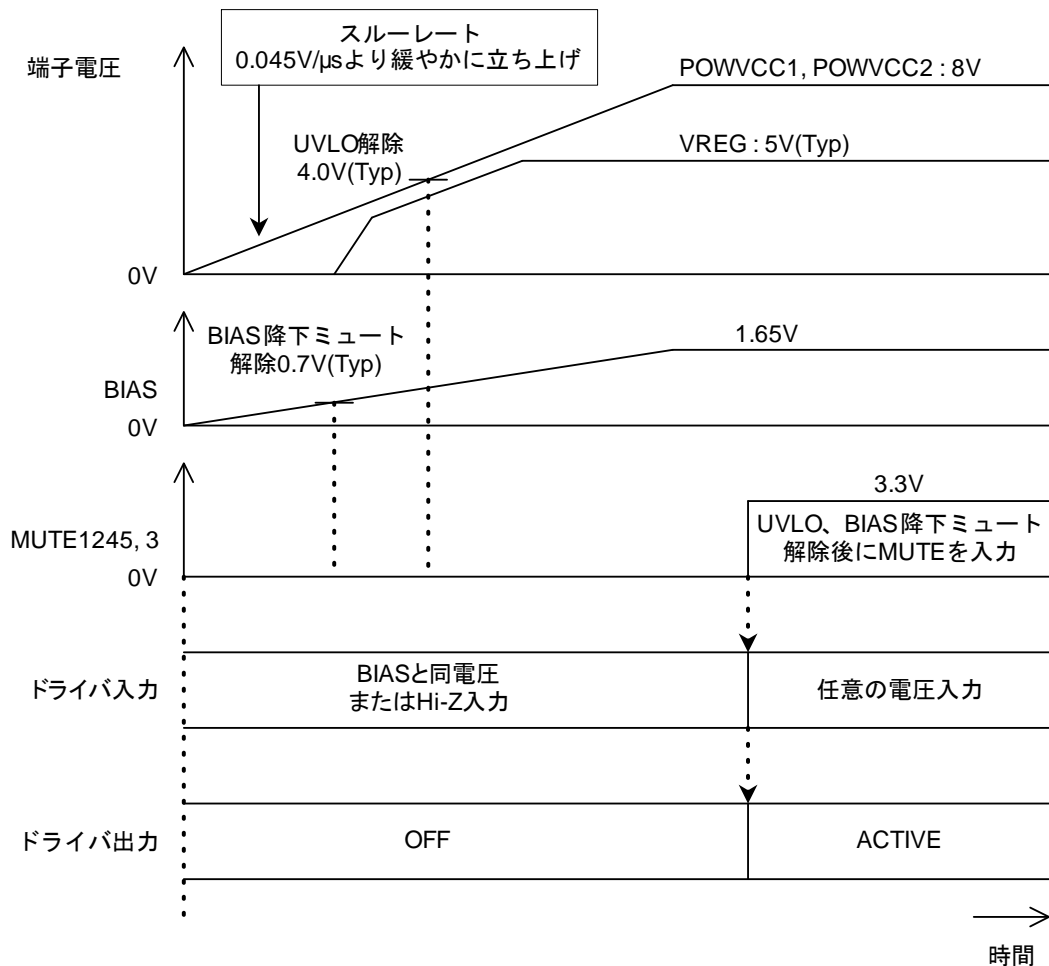


Figure 13. 起動シーケンス例

## 3. 立ち下げシーケンスについて

- (1) ドライバ入力とミュート制御入力をオフします。  
 (2) 基準電圧入力(BIAS)をオフします。なお、BIAS はシーケンスフリーですので、電源投入後のオフも可能です。  
 (3) 電源立ち下げ時、電源電圧が 5V 以下の範囲ではスルーレートが  $-0.045\text{V}/\mu\text{s}$  以上を推奨いたします。急峻に電源電圧を立ち下げますと、 $C_{VREG}$  からの放電電流が過電流となり内部素子破壊に至る可能性があります。また、立ち下げ時につきましても電源電圧  $\text{POWVCC1} \geq \text{POWVCC2}$  の関係を守ってください。

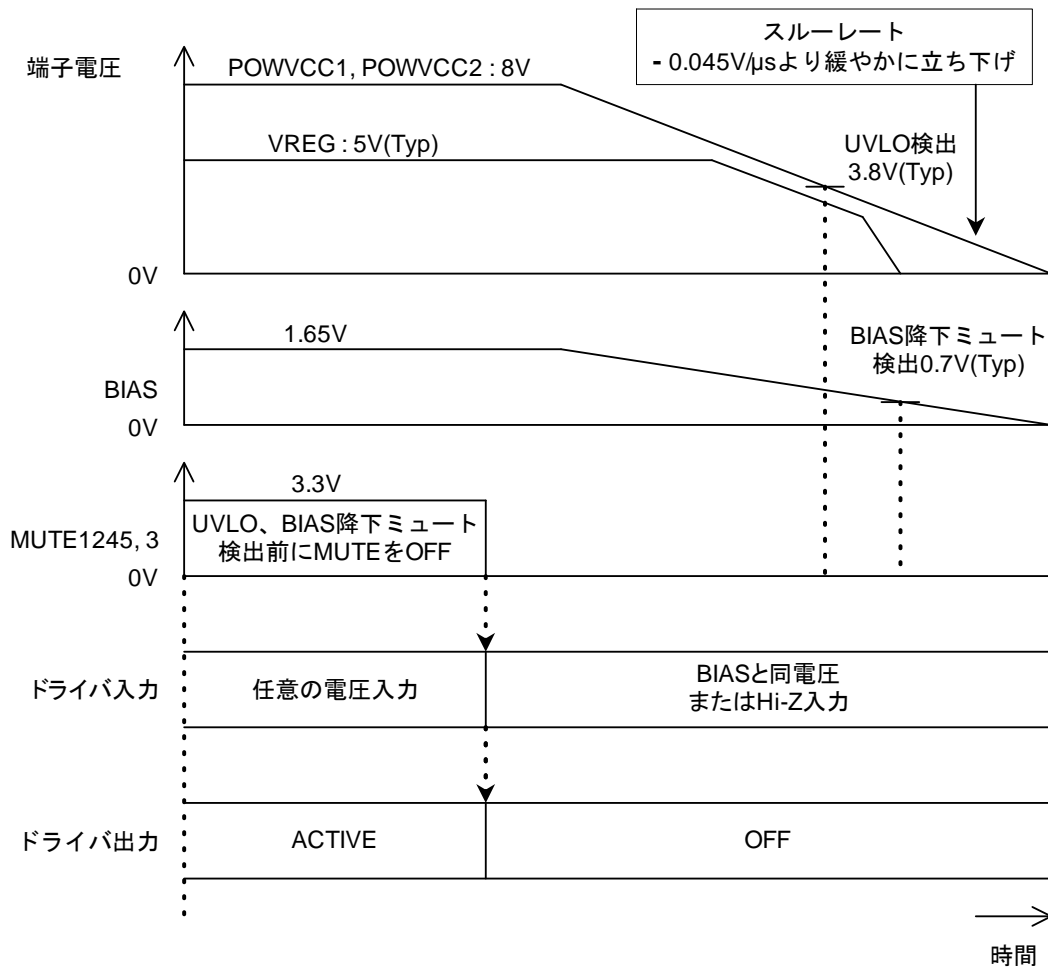


Figure 14. 立ち下げシーケンス例

応用回路例

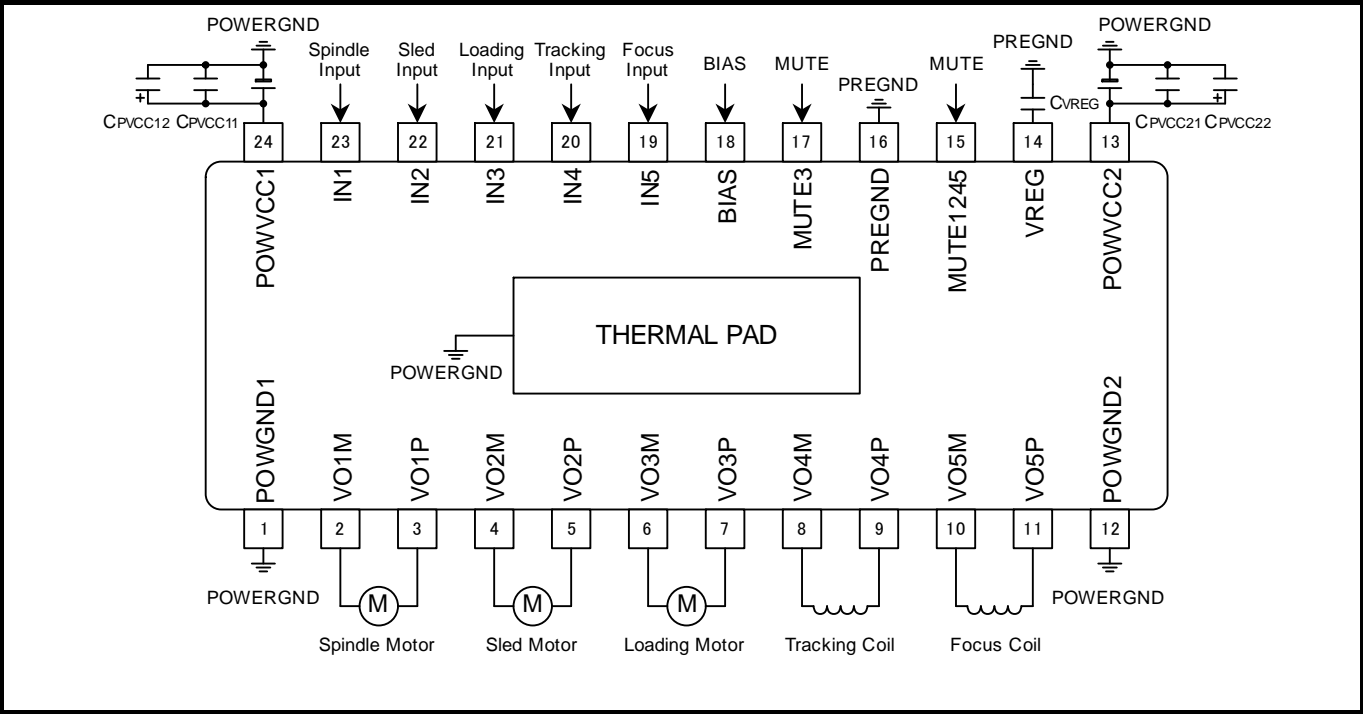


Figure 15. 応用回路例

▼チャンネル割り当て例

CH1	スピンドル(Spindle)
CH2	送りモータ(Sled)
CH3	ローディング>Loading)
CH4	トラッキング>Tracking)
CH5	フォーカス>Focus)

▼推奨定数

Component name	Component value	Product name	Manufacturer
CPVCC11	0.1μF	GCM188R11H104KA42	murata
CPVCC12	47μF	UCD1E470MCL	Nichicon
CPVCC21	0.1μF	GCM188R11H104KA42	murata
CPVCC22	47μF	UCD1E470MCL	Nichicon
CVREG	0.1μF	GCM188R11H104KA42	murata

## 熱損失について

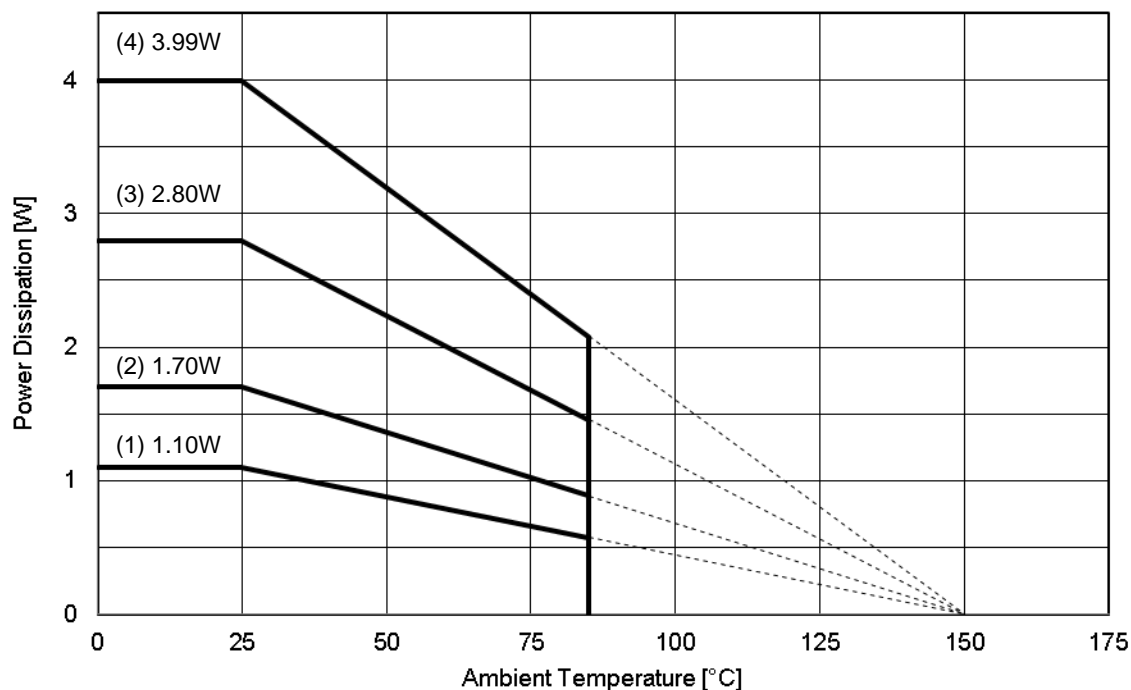


Figure 16. 熱軽減率曲線

## &lt;条件&gt;

- ・ 70.0mm×70.0mm、厚さ 1.6mm、ガラスエポキシ基板実装時(基板の層数・銅箔面積により、値が変化します)
- ・ パッケージ裏面露出放熱板と基板とを半田で接続

基板(1) : 1 層基板 (裏面銅箔 0mm × 0mm)

基板(2) : 2 層基板 (裏面銅箔 15mm × 15mm)

基板(3) : 2 層基板 (裏面銅箔 70mm × 70mm)

基板(4) : 4 層基板 (裏面銅箔 70mm × 70mm)

基板(1) :  $\theta_{ja} = 113.6 \text{ }^{\circ}\text{C/W}$

基板(2) :  $\theta_{ja} = 73.5 \text{ }^{\circ}\text{C/W}$

基板(3) :  $\theta_{ja} = 44.6 \text{ }^{\circ}\text{C/W}$

基板(4) :  $\theta_{ja} = 31.3 \text{ }^{\circ}\text{C/W}$

## 85°C時

基板(1) : 許容損失 = 0.57W

基板(2) : 許容損失 = 0.88W

基板(3) : 許容損失 = 1.45W

基板(4) : 許容損失 = 2.07W

入出力等価回路図(抵抗値と容量値は Typ 値です)

<div>2.VO1M, 3.VO1P, 4.VO2M, 5.VO2P, 6.VO3M, 7.VO3P</div> <div></div>	<div>8.VO4M, 9.VO4P, 10.VO5M, 11.VO5P</div> <div></div>
<div>14.VREG</div> <div></div>	<div>15.MUTE1245, 17.MUTE3</div> <div></div>
<div>18.BIAS</div> <div></div>	<div>19.IN5, 20.IN4</div> <div></div>
<div>21.IN3, 22.IN2, 23.IN1</div> <div></div>	

## 使用上の注意

## 1. 電源の逆接続について

電源コネクタの逆接続により LSI が破壊する恐れがあります。逆接続破壊保護用として外部に電源と LSI の電源端子間にダイオードを入れる等の対策を施してください。

## 2. 電源ラインについて

基板パターンの設計においては、電源ラインの配線は、低インピーダンスになるようにしてください。その際、デジタル系電源とアナログ系電源は、それらが同電位であっても、デジタル系電源パターンとアナログ系電源パターンは分離し、配線パターンの共通インピーダンスによるアナログ電源へのデジタル・ノイズの回り込みを抑止してください。グラウンドラインについても、同様のパターン設計を考慮してください。

また、LSI のすべての電源端子について電源-グラウンド端子間にコンデンサを挿入するとともに、電解コンデンサ使用の際は、低温で容量ぬけが起こることなど使用するコンデンサの諸特性に問題ないことを十分ご確認のうえ、定数を決定してください。

## 3. グラウンド電位について

L 負荷駆動端子については、L 負荷の逆起の影響でグラウンド 以下に振れる事が考えられます。L 負荷駆動端子が逆起電圧によって負電位になる場合を除き、グラウンド 端子はいかなる動作状態においても最低電位になるようにしてください。また実際に過渡現象を含め、グラウンド 端子、L 負荷駆動端子以外のすべての端子がグラウンド 以下の電圧にならないようにしてください。使用条件、環境及び L 負荷個々の特性によっては誤動作等の不具合が発生する可能性があります。IC の動作等に問題のないことを十分ご確認ください。

## 4. グラウンド配線パターンについて

小信号グラウンドと大電流グラウンドがある場合、大電流グラウンドパターンと小信号グラウンドパターンは分離し、パターン配線の抵抗分と大電流による電圧変化が小信号グラウンドの電圧を変化させないように、セットの基準点で 1 点アースすることを推奨します。外付け部品のグラウンドの配線パターンも変動しないよう注意してください。グラウンドラインの配線は、低インピーダンスになるようにしてください。

## 5. 熱設計について

万一、許容損失を超えるようなご使用をされますと、チップ温度上昇により、IC 本来の性質を悪化させることにつながります。本仕様書の絶対最大定格に記載しています許容損失は、70.0mm x 70.0mm x 1.6mm ガラスエポキシ基板実装時、放熱板なし時の値であり、これを超える場合は基板サイズを大きくする、放熱用銅箔面積を大きくする、放熱板を使用する等の対策をして、許容損失を超えないようにしてください。

## 6. 推奨動作条件について

この範囲であればほぼ期待通りの特性を得ることが出来る範囲です。電気特性については各項目の条件下において保証されるものです。推奨動作範囲内であっても電圧、温度特性を示します。

## 7. ラッシュカレントについて

IC 内部論理回路は、電源投入時に論理不定状態で、瞬間的にラッシュカレントが流れる場合がありますので、電源カップリング容量や電源、グラウンドパターン配線の幅、引き回しに注意してください。

## 8. 強電磁界中の動作について

強電磁界中でのご使用では、まれに誤動作する可能性がありますのでご注意ください。

## 9. セット基板での検査について

セット基板での検査時に、インピーダンスの低いピンにコンデンサを接続する場合は、IC にストレスがかかる恐れがあるので、1 工程ごとに必ず放電を行ってください。静電気対策として、組立工程にはアースを施し、運搬や保存の際には十分ご注意ください。また、検査工程での治具への接続をする際には必ず電源を OFF にしてから接続し、電源を OFF にしてから取り外してください。

## 10. 端子間ショートと誤装着について

プリント基板に取り付ける際、IC の向きや位置ずれに十分注意してください。誤って取り付けした場合、IC が破壊する恐れがあります。また、出力と電源及びグラウンド間、出力間に異物が入るなどしてショートした場合についても破壊の恐れがあります。

## 使用上の注意 — 続き

### 11. 未使用の入力端子の処理について

CMOS トランジスタの入力は非常にインピーダンスが高く、入力端子をオープンにすることで論理不定の状態になります。これにより内部の論理ゲートの p チャネル、n チャネルトランジスタが導通状態となり、不要な電源電流が流れます。また 論理不定により、想定外の動作をすることがあります。よって、未使用の端子は特に仕様書上でうたわれない限り、適切な電源、もしくはグラウンドに接続するようにしてください。

### 12. 各入力端子について

本 IC はモノリシック IC であり、各素子間に素子分離のための P+アイソレーションと、P 基板を有しています。この P 層と各素子の N 層とで P-N 接合が形成され、各種の寄生素子が構成されます。

例えば、下図のように、抵抗とトランジスタが端子と接続されている場合、

○抵抗では、GND > (端子 A) の時、トランジスタ (NPN) では GND > (端子 B) の時、P-N 接合が寄生ダイオードとして動作します。

○また、トランジスタ (NPN) では、GND > (端子 B) の時、前述の寄生ダイオードと近接する他の素子の N 層によって寄生の NPN トランジスタが動作します。

IC の構造上、寄生素子は電位関係によって必然的にできます。寄生素子が動作することにより、回路動作の干渉を引き起こし、誤動作、ひいては破壊の原因ともなり得ます。したがって、入出力端子に GND (P 基板) より低い電圧を印加するなど、寄生素子が動作するような使い方をしないよう十分に注意してください。アプリケーションにおいて電源端子と各端子電圧が逆になった場合、内部回路または素子を損傷する可能性があります。例えば、外付けコンデンサに電荷がチャージされた状態で、電源端子が GND にショートされた場合などです。また、電源端子直列に逆流防止のダイオードもしくは各端子と電源端子間にバイパスのダイオードを挿入することを推奨します。

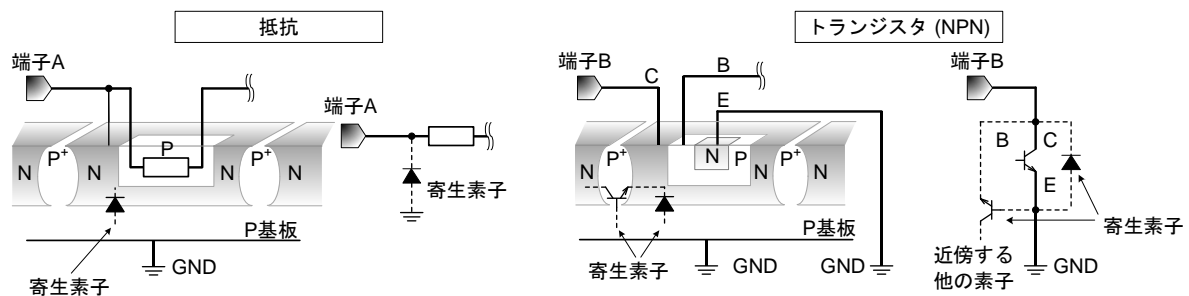


Figure 17. モノリシック IC 構造例

### 13. セラミック・コンデンサの特性変動について

外付けコンデンサに、セラミック・コンデンサを使用する場合、直流バイアスによる公称容量の低下、及び温度などによる容量の変化を考慮の上定数を決定してください。

### 14. 安全動作領域について

本製品を使用する際には、出力トランジスタが絶対最大定格及び ASO を越えないよう設定してください。

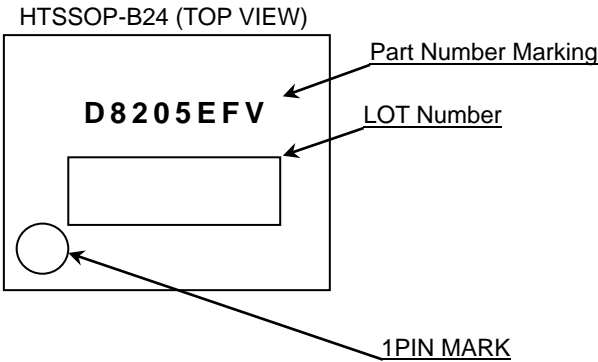
### 15. 温度保護回路について

IC を熱破壊から防ぐための温度保護回路を内蔵しております。許容損失範囲内でご使用いただきますが、万が一許容損失を超えた状態が継続すると、チップ温度  $T_j$  が上昇し温度保護回路が動作し出力パワー素子が OFF します。その後チップ温度  $T_j$  が低下すると回路は自動で復帰します。なお、温度保護回路は絶対最大定格を超えた状態での動作となりますので、温度保護回路を使用したセット設計等は、絶対に避けてください。

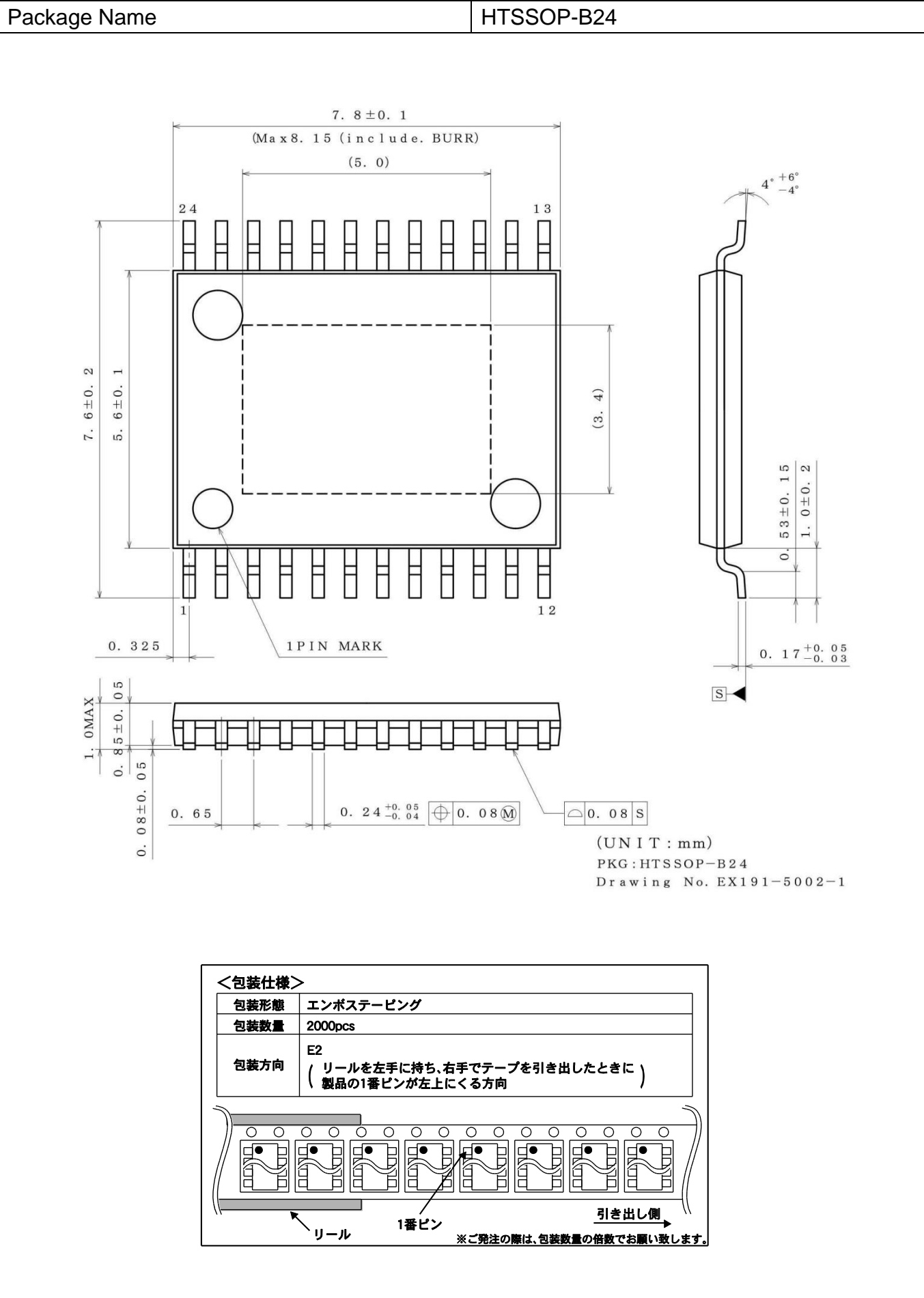
発注形名情報

B D 8 2 0 5 E F V										-	M E 2		
形名										パッケージ EFV : HTSSOP-B24			包装・フォーミング仕様 M : 車載ランク製品 E2 : リール状エンボステーパーピング (HTSSOP-B24)

標印図



外形寸法図と包装・フォーミング仕様



改訂履歴

日付	Revision	改訂内容
2014.12.04	001	Rev.001 新規作成

# ご注意

## ローム製品取扱い上の注意事項

- 極めて高度な信頼性が要求され、その故障や誤動作が人の生命、身体への危険もしくは損害、又はその他の重大な損害の発生に関わるような機器又は装置（医療機器<sup>(Note 1)</sup>、航空宇宙機器、原子力制御装置等）（以下「特定用途」という）への本製品のご使用を検討される際は事前にローム営業窓口までご相談くださいますようお願い致します。ロームの文書による事前の承諾を得ることなく、特定用途に本製品を使用したことによりお客様又は第三者に生じた損害等に関し、ロームは一切その責任を負いません。

(Note 1) 特定用途となる医療機器分類

日本	USA	EU	中国
CLASS III	CLASS III	CLASS II b	Ⅲ類
CLASS IV		CLASS III	

- 半導体製品は一定の確率で誤動作や故障が生じる場合があります。万が一、誤動作や故障が生じた場合であっても、本製品の不具合により、人の生命、身体、財産への危険又は損害が生じないように、お客様の責任において次の例に示すようなフェールセーフ設計など安全対策をお願い致します。
  - ①保護回路及び保護装置を設けてシステムとしての安全性を確保する。
  - ②冗長回路等を設けて単一故障では危険が生じないようにシステムとしての安全を確保する。
- 本製品は、下記に例示するような特殊環境での使用を配慮した設計はなされておられません。したがって、下記のような特殊環境での本製品のご使用に関し、ロームは一切その責任を負いません。本製品を下記のような特殊環境でご使用される際は、お客様におかれまして十分に性能、信頼性等をご確認ください。
  - ①水・油・薬液・有機溶剤等の液体中でのご使用
  - ②直射日光・屋外暴露、塵埃中でのご使用
  - ③潮風、Cl<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>S、NH<sub>3</sub>、SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>等の腐食性ガスの多い場所でのご使用
  - ④静電気や電磁波の強い環境でのご使用
  - ⑤発熱部品に近接した取付け及び当製品に近接してビニール配線等、可燃物を配置する場合
  - ⑥本製品を樹脂等で封止、コーティングしてのご使用
  - ⑦はんだ付けの後に洗浄を行わない場合(無洗浄タイプのフラックスを使用された場合も、残渣の洗浄は確実にを行うことをお勧め致します)、又ははんだ付け後のフラックス洗浄に水又は水溶性洗浄剤をご使用の場合
  - ⑧結露するような場所でのご使用
- 本製品は耐放射線設計はなされておられません。
- 本製品単体品の評価では予測できない症状・事態を確認するためにも、本製品のご使用にあたってはお客様製品に実装された状態での評価及び確認をお願い致します。
- パルス等の過渡的な負荷（短時間での大きな負荷）が加わる場合は、お客様製品に本製品を実装した状態で必ずその評価及び確認の実施をお願い致します。また、定常時での負荷条件において定格電力以上の負荷を印加されますと、本製品の性能又は信頼性が損なわれるおそれがあるため必ず定格電力以下でご使用ください。
- 電力損失は周囲温度に合わせてディレーティングしてください。また、密閉された環境下でご使用の場合は、必ず温度測定を行い、最高接合部温度を超えていない範囲であることをご確認ください。
- 使用温度は納入仕様書に記載の温度範囲内であることをご確認ください。
- 本資料の記載内容を逸脱して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは一切その責任を負いません。

## 実装及び基板設計上の注意事項

- ハロゲン系（塩素系、臭素系等）の活性度の高いフラックスを使用する場合、フラックスの残渣により本製品の性能又は信頼性への影響が考えられますので、事前にお客様にてご確認ください。
- はんだ付けは、表面実装製品の場合リフロー方式、挿入実装製品の場合フロー方式を原則とさせていただきます。なお、表面実装製品をフロー方式での使用をご検討の際は別途ロームまでお問い合わせください。  
その他、詳細な実装条件及び手はんだによる実装、基板設計上の注意事項につきましては別途、ロームの実装仕様書をご確認ください。

**応用回路、外付け回路等に関する注意事項**

1. 本製品の外付け回路定数を変更してご使用になる際は静特性のみならず、過渡特性も含め外付け部品及び本製品のバラツキ等を考慮して十分なマージンをみて決定してください。
2. 本資料に記載された応用回路例やその定数などの情報は、本製品の標準的な動作や使い方を説明するためのもので、実際に使用する機器での動作を保証するものではありません。したがって、お客様の機器の設計において、回路やその定数及びこれらに関連する情報を使用する場合には、外部諸条件を考慮し、お客様の判断と責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様又は第三者に生じた損害に関し、ロームは一切その責任を負いません。

**静電気に対する注意事項**

本製品は静電気に対して敏感な製品であり、静電放電等により破壊することがあります。取り扱い時や工程での実装時、保管時において静電気対策を実施のうえ、絶対最大定格以上の過電圧等が印加されないようにご使用ください。特に乾燥環境下では静電気が発生しやすくなるため、十分な静電対策を実施ください。（人体及び設備のアース、帯電物からの隔離、イオナイザの設置、摩擦防止、温湿度管理、はんだごてのこて先のアース等）

**保管・運搬上の注意事項**

1. 本製品を下記の環境又は条件で保管されますと性能劣化やはんだ付け性等の性能に影響を与えるおそれがありますのでこのような環境及び条件での保管は避けてください。
  - ① 潮風、Cl<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>S、NH<sub>3</sub>、SO<sub>2</sub>、NO<sub>2</sub>等の腐食性ガスの多い場所での保管
  - ② 推奨温度、湿度以外での保管
  - ③ 直射日光や結露する場所での保管
  - ④ 強い静電気が発生している場所での保管
2. ロームの推奨保管条件下におきましても、推奨保管期限を経過した製品は、はんだ付け性に影響を与える可能性があります。推奨保管期限を経過した製品は、はんだ付け性を確認したうえでご使用頂くことを推奨します。
3. 本製品の運搬、保管の際は梱包箱を正しい向き（梱包箱に表示されている天面方向）で取り扱ってください。天面方向が遵守されずに梱包箱を落下させた場合、製品端子に過度なストレスが印加され、端子曲がり等の不具合が発生する危険があります。
4. 防湿梱包を開封した後は、規定時間内にご使用ください。規定時間を経過した場合はベーク処置を行ったうえでご使用ください。

**製品ラベルに関する注意事項**

本製品に貼付されている製品ラベルに2次元バーコードが印字されていますが、2次元バーコードはロームの社内管理のみを目的としたものです。

**製品廃棄上の注意事項**

本製品を廃棄する際は、専門の産業廃棄物処理業者にて、適切な処置をしてください。

**外国為替及び外国貿易法に関する注意事項**

本製品は、外国為替及び外国貿易法に定めるリスト規制貨物等に該当するおそれがありますので、輸出する場合には、ロームへお問い合わせください。

**知的財産権に関する注意事項**

1. 本資料に記載された本製品に関する応用回路例、情報及び諸データは、あくまでも一例を示すものであり、これらに関する第三者の知的財産権及びその他の権利について権利侵害がないことを保証するものではありません。
2. ロームは、本製品とその他の外部素子、外部回路あるいは外部装置等（ソフトウェア含む）との組み合わせに起因して生じた紛争に関して、何ら義務を負うものではありません。
3. ロームは、本製品又は本資料に記載された情報について、ロームもしくは第三者が所有又は管理している知的財産権その他の権利の実施又は利用を、明示的にも黙示的にも、お客様に許諾するものではありません。ただし、本製品を通常の用法にて使用される限りにおいて、ロームが所有又は管理する知的財産権を利用されることを妨げません。

**その他の注意事項**

1. 本資料の全部又は一部をロームの文書による事前の承諾を得ることなく転載又は複製することを固くお断り致します。
2. 本製品をロームの文書による事前の承諾を得ることなく、分解、改造、改変、複製等しないでください。
3. 本製品又は本資料に記載された技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用、あるいはその他軍事用途目的で使用しないでください。
4. 本資料に記載されている社名及び製品名等の固有名詞は、ローム、ローム関係会社もしくは第三者の商標又は登録商標です。

**一般的な注意事項**

1. 本製品をご使用になる前に、本資料をよく読み、その内容を十分に理解されるようお願い致します。本資料に記載される注意事項に反して本製品をご使用されたことによって生じた不具合、故障及び事故に関し、ロームは一切その責任を負いませんのでご注意願います。
2. 本資料に記載の内容は、本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。本製品のご購入及びご使用に際しては、事前にローム営業窓口で最新の情報をご確認ください。
3. ロームは本資料に記載されている情報は誤りがないことを保証するものではありません。万が一、本資料に記載された情報の誤りによりお客様又は第三者に損害が生じた場合においても、ロームは一切その責任を負いません。